

Elektronika

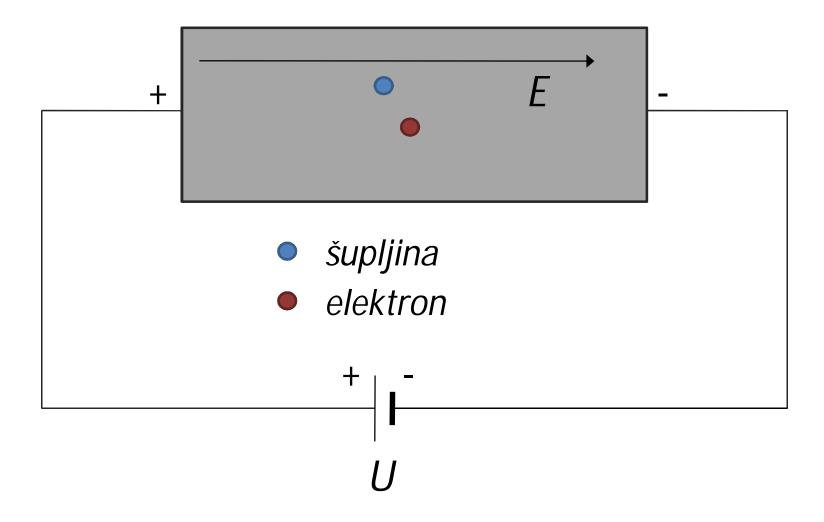
Auditorne vježbe 4

Gibanje nosilaca u poluvodiču

- Usmjereno gibanje nosilaca električna struja.
- Smjer struje:
 - Jednak smjeru gibanja pozitivnih naboja (šupljina).
 - Suprotan smjeru gibanja negativnih naboja (elektrona).
- Dva osnovna mehanizma:
 - Električno polje DRIFT
 - Nejednolika raspodjela nosilaca DIFUZIJA

Driftno gibanje

Gibanje nosilaca pod utjecajem električnog polja.



Driftno gibanje

- O čemu ovisi driftno gibanje?
- Iznos i smjer priključenog električnog polja!
- Sposobnost gibanja elektrona i šupljine u poluvodiču POKRETLJIVOST!
- Pokretljivost: μ [cm²/Vs]
 - elektrona μ_n
 - šupljina μ_p
- Pokretljivost ovisi o:
 - gustoći primjesa
 - temperaturi
 - jakosti električnog polja
 - raspršenju i međusobnim sudarima nosilaca i dr.



Pokretljivost nosilaca

• U siliciju na *T*=300 K:

$$\mu = \mu_{\min} + \frac{\mu_{maks} - \mu_{\min}}{1 + \left(\frac{N}{N_{ref}}\right)^{\alpha}}$$

nosilac	N _{ref} [cm ⁻³]	µ _{maks} [cm ² V ⁻¹ s ⁻¹]	μ _{min} [cm ² V ⁻¹ s ⁻¹]	α
elektron	1,12·10 ¹⁷	1430	80	0,72
šupljina	2,23·10 ¹⁷	460	45	0,72

Električna provodnost

- Električna provodnost: σ [S/cm]
- Ukupna provodnost poluvodiča je zbroj provodnosti zbog gibanja elektrona i šupljina:

$$\sigma = \sigma_n + \sigma_p$$

$$\sigma_n = q \cdot n \cdot \mu_n \qquad \sigma_p = q \cdot p \cdot \mu_p$$

Driftna struja

- Gustoća struje: J [A/cm²]
- Driftno gibanje elektrona:

$$J_{n \, drift} = q \cdot \mu_n \cdot n \cdot E$$

Driftno gibanje šupljina:

$$J_{p \, drift} = q \cdot \mu_p \cdot p \cdot E$$

Difuzijsko gibanje

- Nejednolika raspodjela nosilaca u volumenu poluvodiča.
- Gibanje nosilaca: iz područja veće u područje manje gustoće.
- Difuzijsko gibanje traje dok se gustoća ne izjednači u cijelom volumenu.
- Difuzijska konstanta: D [cm²/s]
 - elektrona D_n
 - šupljina D_p



Difuzijska struja

- Gustoća struje: J [A/cm²]
- Difuzijsko gibanje elektrona:

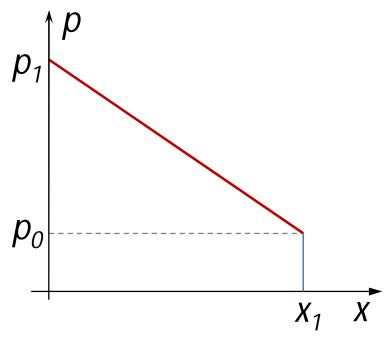
$$J_{ndif} = +q \cdot D_n \cdot \frac{dn}{dx}$$

Difuzijsko gibanje šupljina:

$$J_{pdif} = -q \cdot D_p \cdot \frac{dp}{dx}$$

Zadatak 6.

Djelovanjem svjetla generiraju se dodatni (*ekscesni*)
nosioci uz površinu silicija. Odediti sve komponente
struja (difuzijske i driftne) većinskih i manjinskih
nosilaca,ako je raspodjela šupljina dana prema
prikazanom crtežu:



Poznato je još:

$$T = 300 \text{ K}$$

$$x_1 = 10 \, \mu \text{m}$$

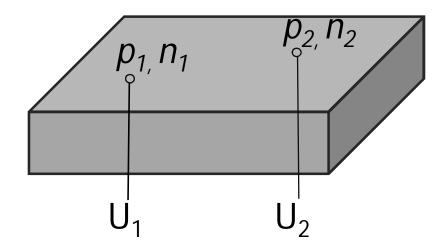
$$p_0 = 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

a)
$$p_1 = 10^8 \text{ cm}^{-3}$$

b)
$$p_2 = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

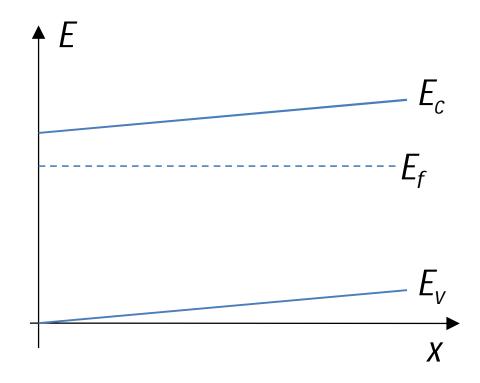
Zadatak 7.

Odrediti razliku potencijala između točaka 1 i 2 sa slike ako je u točki 1 gustoća elektrona n₁=2·10¹⁴ cm⁻³ i šupljina p₁=1,5 · 10¹⁴ cm⁻³, a u točki 2 je gustoća elektrona n₂=10¹⁴ cm⁻³. Koliki je iznos gustoće p₂? T=300 K.



Nehomogeni poluvodič

- Gustoća primjesa nejednoliko raspodijeljena → stalni gradijent gustoće nosilaca.
- Ravnotežno stanje: ukupna struja = 0.



Generacija i rekombinacija

- Stvaranje nosilaca generacija.
- Nestajanje (poništavanje) nosilaca rekombinacija.
- Vrijeme života vrijeme od nastanka do nestanka.
- Vrijeme života manjinskih nosilaca u Si na T=300 K:

$$\tau_{p} = \frac{\tau_{p0}}{1 + \frac{N_{D}}{N_{0D}}} \qquad \tau_{n} = \frac{\tau_{n0}}{1 + \frac{N_{A}}{N_{0A}}}$$

- $\tau_{p0} = 3.52 \cdot 10^{-5} \text{ s}, N_{0D} = 7.1 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$
- $\tau_{n0} = 1.7 \cdot 10^{-5} \text{ s}, N_{0A} = 7.1 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$